

Collège Doctoral
Bâtiment Pluriel – 701 rue de la Piscine
BP 81 – FR – 38402 SAINT MARTIN D'HÈRES
Tél. 04 76 82 40 24 – Fax 04 76 82 40 40

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

Pour confirmation des horaires et lieu de soutenance de la thèse par le doctorant et diffusion via Internet par le service des études doctorales à une liste préétablie de destinataires

DATE ET HEURE de la soutenance de la thèse : jeudi 5 avril 2018 à 10h30

Soutenance de **Antoine LAURENT** pour une thèse de DOCTORAT de l'Université Grenoble Alpes,
spécialité : NANO ELECTRONIQUE ET NANO TECHNOLOGIES

Intitulé de la thèse : « Etude des mécanismes physiques de fiabilité sur transistors Trigate/Nanowire »

Lieu de soutenance de la Thèse : Phelma Minatec - Bâtiment Z - 1er étage 3 Parvis Louis Neel 38000 Grenoble - salle Z103

Thèse préparée dans le **laboratoire** : UMR 5130 - Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique - Laboratoire d'hyperfréquences et de caractérisation ,

sous la direction de Gérard GHIBAUDO, directeur de thèse et Xavier GARROS Co-encadrant.

Membres du jury :

- Gérard GHIBAUDO - Directeur de these
- Alain Bravaix - Rapporteur
- Nathalie Malbert - Rapporteur
- Francis Balestra - Examineur

Résumé de thèse :

En continuant à suivre la loi de Moore, les transistors ont atteint des dimensions de plus en plus réduites. Cependant pour les largeurs inférieures à 100nm, des effets parasites dits de canaux courts sont apparus. Il a ainsi fallu développer de nouvelles architectures, à savoir les transistors 3D, aussi appelés trigates, finfets ou encore nanofils. Le remplacement des transistors planaires utilisés depuis les années 60 par ces dispositifs tridimensionnels constitue une réelle rupture technologique et pose de sérieuses questions quant à la fiabilité de ces nouveaux composants électroniques. Parmi les spécificités des dispositifs 3D, on peut notamment citer l'utilisation de différents plans cristallins du silicium, les potentiels effets d'angle ou encore le confinement des porteurs de charge. Les principaux mécanismes de fiabilité doivent, à ce titre, être étudiés afin de prédire le vieillissement de tels dispositifs. Ainsi, l'évolution du transistor MOS et les limites de l'architecture planaire sont rappelées dans un premier temps. Les différents mécanismes de dégradation ainsi que les méthodes de caractérisation sont également exposés. Les défauts d'oxyde jouant un rôle important en fiabilité, l'impact sur la tension de seuil V_T d'une charge élémentaire q selon sa localisation spatiale a été simulé. On a ainsi pu constater que l'influence de ces défauts change selon leur position mais aussi selon les dimensions du transistor lui-même. Par la suite, le manuscrit se concentre sur la dégradation BTI (Bias Temperature Instabilities). Une comparaison entre les transistors trigates et d'autres quasi planaires a ainsi été effectuée en mettant en évidence les effets de la largeur du MOSFET. Un autre mécanisme important de fiabilité est intitulé dégradation par porteurs chauds ou HC, hot carriers en anglais. Les principaux modèles développés sur les architectures planaires ont été rappelés puis vérifiés pour les transistors 3D. Lors de stress HC, les niveaux de courant sont tels que des effets d'auto-échauffement apparaissent et dégradent les

paramètres électriques du dispositif. Cette contribution a alors dû être décorrélée de la contrainte porteurs chauds afin d'obtenir uniquement la dégradation HC. De manière similaire au BTI, les effets de la largeur du transistor ont également été analysés pour ce mécanisme de fiabilité. Enfin, l'effet des contraintes mécaniques dans le canal, telles que le strained-SOI ou l'apport de germanium, a été étudié non seulement du point de vue des performances mais également de la fiabilité. Nous avons alors pu en déduire le meilleur compromis performance/fiabilité réalisable.

Fait à Grenoble, le *

Le doctorant Antoine LAURENT

* La date sera mise ultérieurement lorsque l'autorisation de soutenance de thèse aura été accordée par la direction du SED

Communauté Université Grenoble Alpes

Bâtiment les Taillées • 271 rue de la Houille Blanche • DOMAINE UNIVERSITAIRE • 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES • FRANCE

Tel. +33 4 76 82 83 84 • E-mail : contact@grenoble-univ.fr